

# 2SC3624,3624A

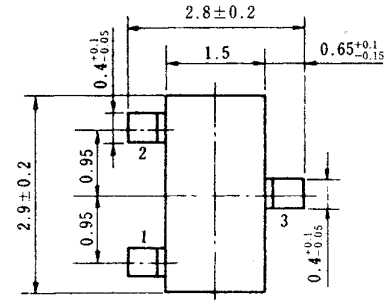
NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ  
低周波増幅およびスイッチング用

NPN Silicon Epitaxial Transistor  
Audio Frequency Amplifier, Switching

特長/FEATURES

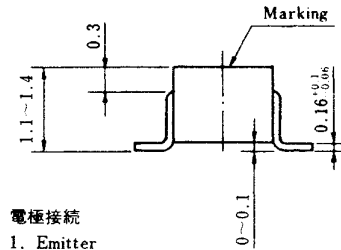
- 高 $h_{FE}$ です。  
 $h_{FE}=1000\sim 3200$  @  $V_{CE}=5.0$  V,  $I_C=1.0$  mA
- 低 $V_{CE(sat)}$ です。  
 $V_{CE(sat)}=0.07$  V TYP. @  $I_C/I_B=50$  mA/5.0 mA
- 高 $V_{EBO}$ です。  $V_{EBO}: 12$  V (2SC3624)  
 $V_{EBO}: 15$  V (2SC3624A)

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit : mm)



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS( $T_a=25$  °C)

項目	略号	定 格		単 位
		2SC3624	2SC3624A	
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60		V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	50		V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	12	15	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	150		mA
全 損 失	$P_T$	200		mW
ジャンクション温度	$T_j$	150		°C
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55~+150		°C



電極接続  
1. Emitter  
2. Base  
3. Collector

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS( $T_a=25$  °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50$ V, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=10$ V, $I_C=0$			100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE}=5.0$ V, $I_C=1.0$ mA	1000	1800	3200	—
直流電流増幅率	$h_{FE2}^*$	$V_{CE}=5.0$ V, $I_C=100$ mA	200	350		
直流ベース電圧	$V_{BE}^*$	$V_{CE}=5.0$ V, $I_C=1.0$ mA		560		mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}^*$	$I_C=50$ mA, $I_B=5.0$ mA		0.07	0.30	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}^*$	$I_C=50$ mA, $I_B=5.0$ mA		0.8	1.2	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=5.0$ V, $I_E=-10$ mA		250		MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=5$ V, $I_E=0$ , $f=1.0$ MHz		3.0		pF
ターンオン時間	$t_{on}$	$V_{CC}=10$ V, $V_{BE(off)}=-2.7$ V $I_C=50$ mA $I_{B1}=-I_{B2}=1$ mA		0.13		$\mu$ s
蓄積時間	$t_{stg}$			0.72		$\mu$ s
ターンオフ時間	$t_{off}$			1.22		$\mu$ s

\*パルス測定 PW $\leq$ 350  $\mu$ s, Duty Cycle $\geq$ 2 % / Pulsed

$h_{FE}$ 規格区分

捺 印	2SC3624	L17	L18
	2SC3624A	L15	L16
$h_{FE1}$	1000~2000	1600~3200	

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

